**Załącznik 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych (wafers) wymienionych poniżej wg nazwy i potrzebnej ilości:

1. GaAs N-type 3” SSP 100 sztuk

1. **Zakres przedmiotu zamówienia**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu.

1. **Kryteria**

Oferty oceniane będą wg skali punktowej z maksymalną liczbą punktów wynoszącą 100.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium | Maksymalna ilość punktów S | Metoda przyznawania punktów |
| Cena netto (P) | 100 | S x Pmin/Pi |

Gdzie:

* Pi – cena netto towarów wraz z dostawą - dla danej przedłożonej oferty
* Pmin - minimalna cena netto dostawy zamawianych towarów spośród wszystkich przedłożonych ofert
* S – liczba punktów

Końcowa punktacja zostanie wyliczona poprzez zsumowanie składowych cząstkowych, a następnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. (zaokrąglając od „5” w górę)

1. **Termin wykonania zamówienia**

Do 9 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms 2020. EXW (ex works) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.). .

1. **Parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr  | Specyfikacja |
| **GaAs N-type**  | Średnica 3” Grubość: 625±25 µmŚrednica: 76.2±0.1 mm | Jakość: | Pierwsza, tzw. “epi-ready” |
| Domieszka | Si |
| Orientatcja: | (100)±0.1o |
| Ścięcie bazowe: | EJ (0-1-1) ±1o |
| Ścięcie pomocnicze | EJ (0-11) ±2o |
| Koncentracja nośników.: | 0.8-4E18/cm3 |
| EPD (średnia): | 500/cm2 max |
| TTV: | 15 micr. max |
| TIR: | 10 micr. max |
| wykrzywienie: | 15 micr. max |
| Off-orientation | No miscut |
| Wykończenie powierzchni | Jednostronnie polerowana |
| Pakowanie: | ePAK, pojedyncze pudełko, zamknięte N2 w zatrzymującej wilgoć metalowej torebce foliowej, pakowanie wykonane w pomieszczeniu o klasie czystości 100. |